



主要特点

工作频率: 18-50 GHz

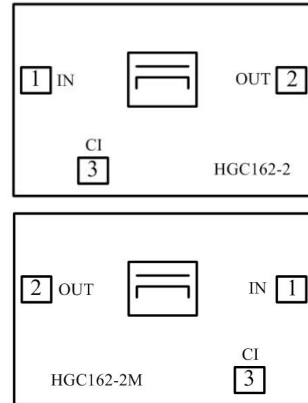
插入损耗: 0.8 dB @ 50 GHz

耦合度: 15 dB

耦合度平坦度: ± 1.2 dB

芯片尺寸: $1.4 \times 1 \times 0.1$ mm³

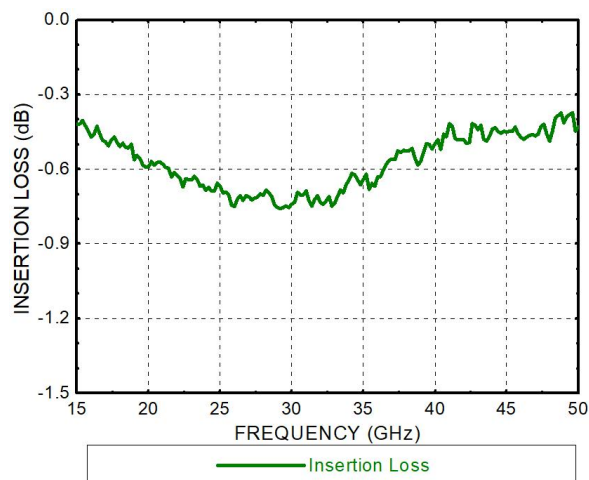
功能框图



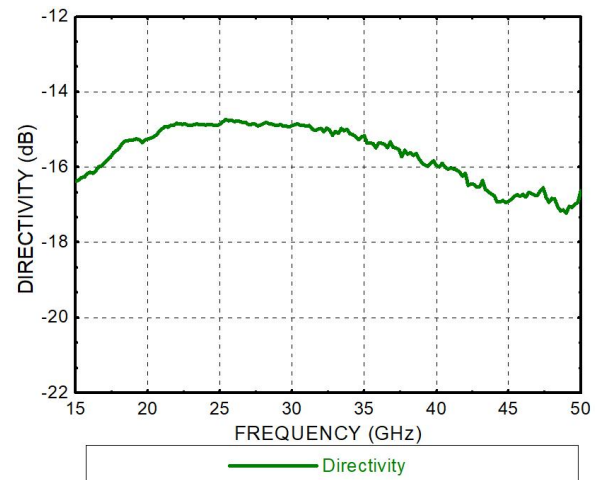
性能指标

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	18 - 50			GHz
插入损耗		0.8		dB
耦合度	14.7	15	17.2	dB
耦合度平坦度		± 1.2		dB
端口回波损耗		15		dB
隔离度		25		dB

插入损耗



耦合度





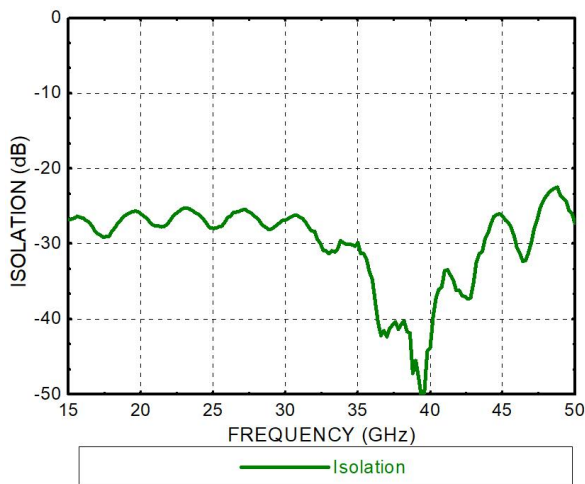
中科海高
HiGaAs Microwave

V01.2022

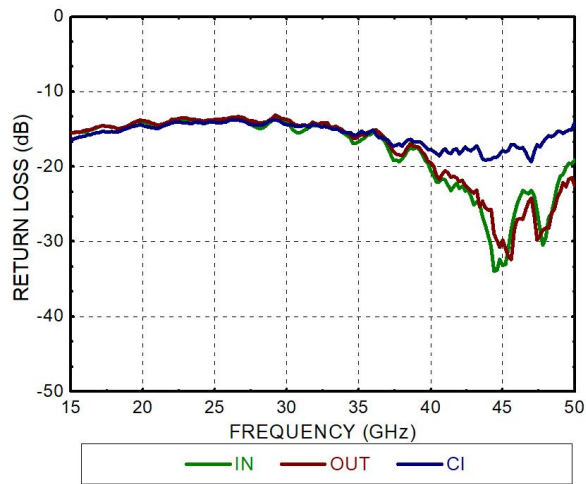
HGC162-2/HGC162-2M

GaAs MMIC
定向耦合器, 18 - 50 GHz

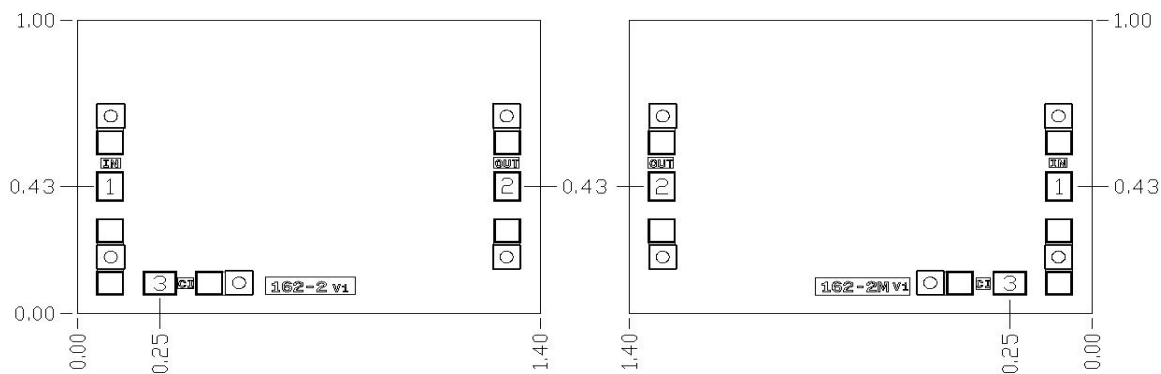
隔离度



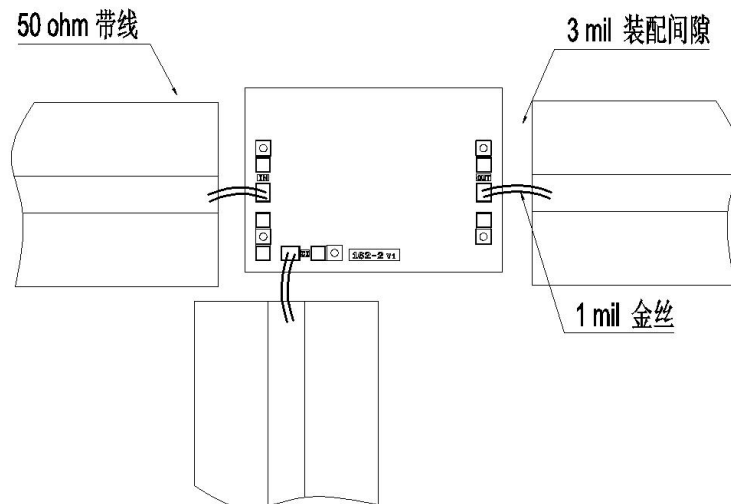
回波损耗



物理参数

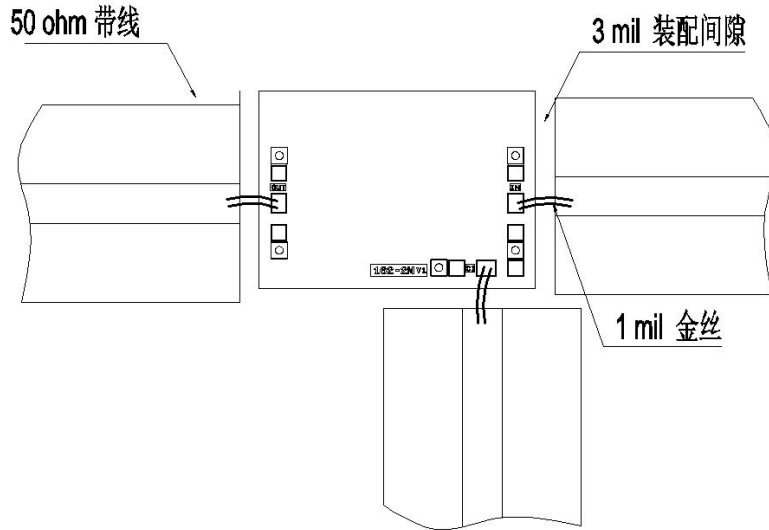


推荐电路图@162-2





推荐电路图@162-2M



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是射频信号输入端口
2	OUT	该焊盘是射频信号输出端口
3	CI	该焊盘是耦合端口
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

极限参数

最大输入功率	+43 dBm
存储温度	-65 ~ +175° C
工作温度	-55 ~ +85° C